

Judul:

Perancangan struktur HBT Si/SiGe yang optimal untuk memperoleh frekuensi transit dan penguatan arus yang tinggi dengan model HBT yang memperhitungkan mekanisme difusi, drift dan emisi termionik

Pengarang/Penulis:

Engelin Shintadewi Julian, author

Subjek:

Semiconductors.

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)